

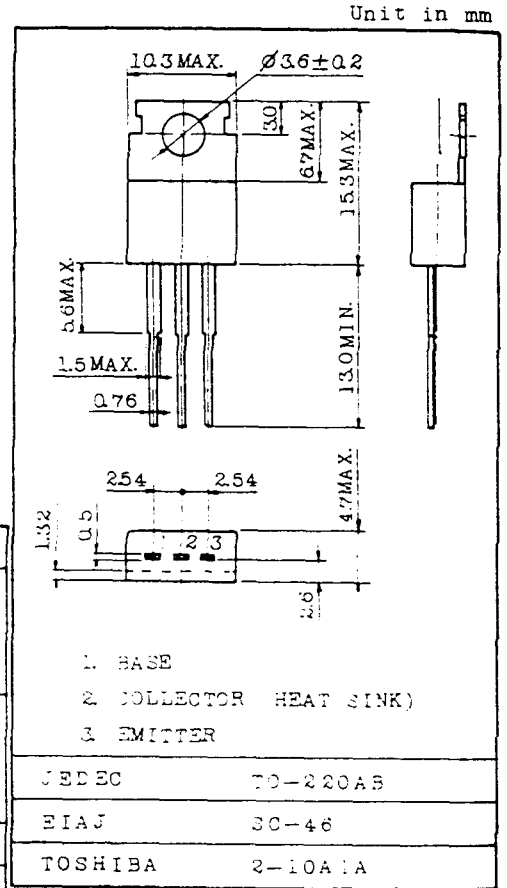
2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 電力増幅用
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.
- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T = 100\text{MHz}$ (Typ.)
- ・ 2SA968とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66)の2SC2239もあります。
- ・ Complementary to 2SA968.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SC2238	160	V
	2SC2238A	180	
	2SC2238B	200	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SC2238	160	V
	2SC2238A	180	
	2SC2238B	200	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	1.5	A
エミッタ電流	I_E	-1.5	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	25	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



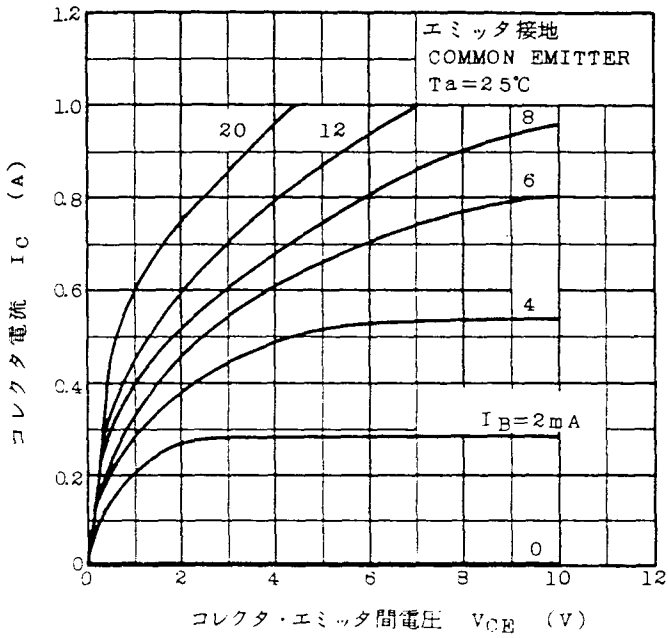
アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

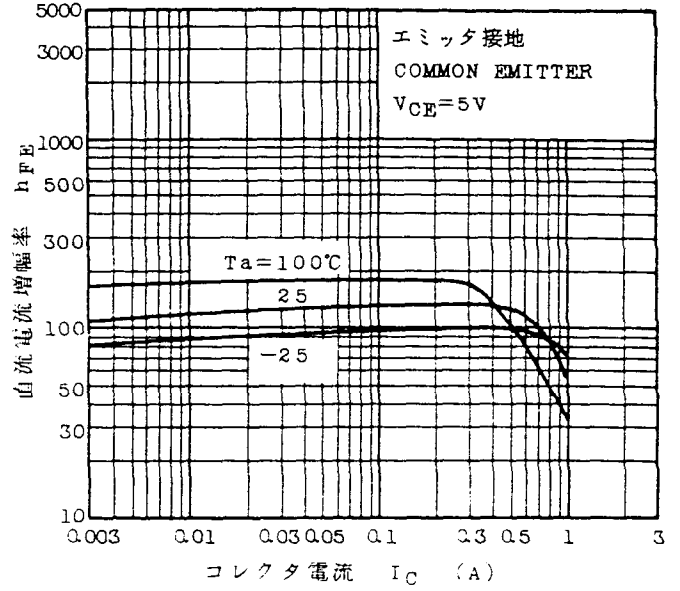
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 160\text{V}, I_E = 0$	-	-	1.0	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5\text{V}, I_C = 0$	-	-	1.0	μA
コレクタ・エミッタ 間降伏電圧	2SC2238	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0$	160	-	-	V
	2SC2238A		180	-	-	
	2SC2238B		200	-	-	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 1\text{mA}, I_C = 0$	5	-	-	V
直流電流増幅率	h_{FE} (Note)	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 100\text{mA}$	70	-	240	-
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{mA}, I_B = 50\text{mA}$	-	-	1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 500\text{mA}$	-	-	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10\text{V}, I_C = 100\text{mA}$	-	100	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10\text{V}, I_C = 0, f = 1\text{MHz}$	-	25	-	pF

2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

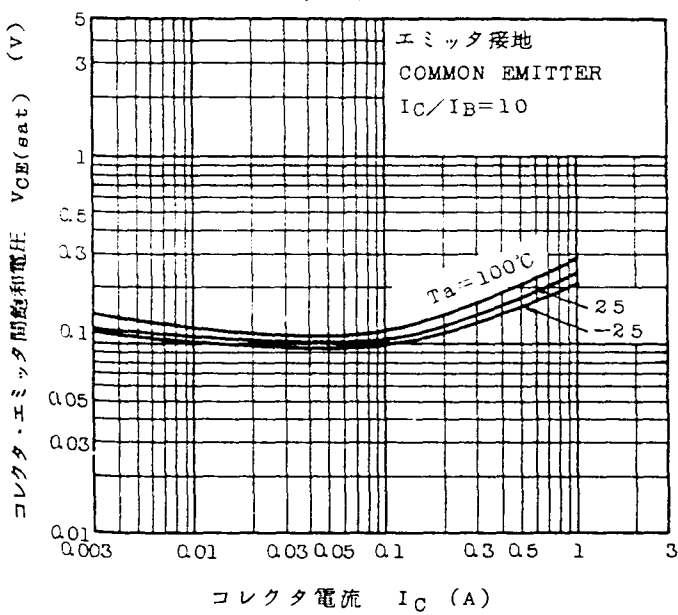
$I_C - V_{CE}$



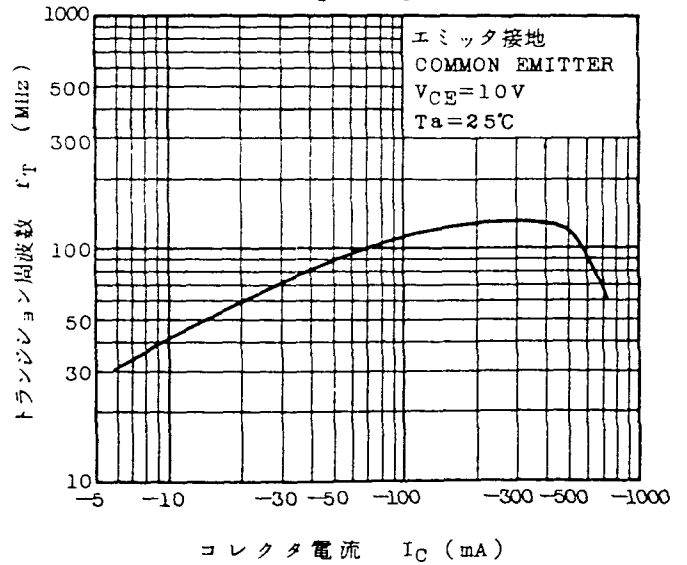
$h_{FE} - I_C$



$V_{CE(sat)} - I_C$

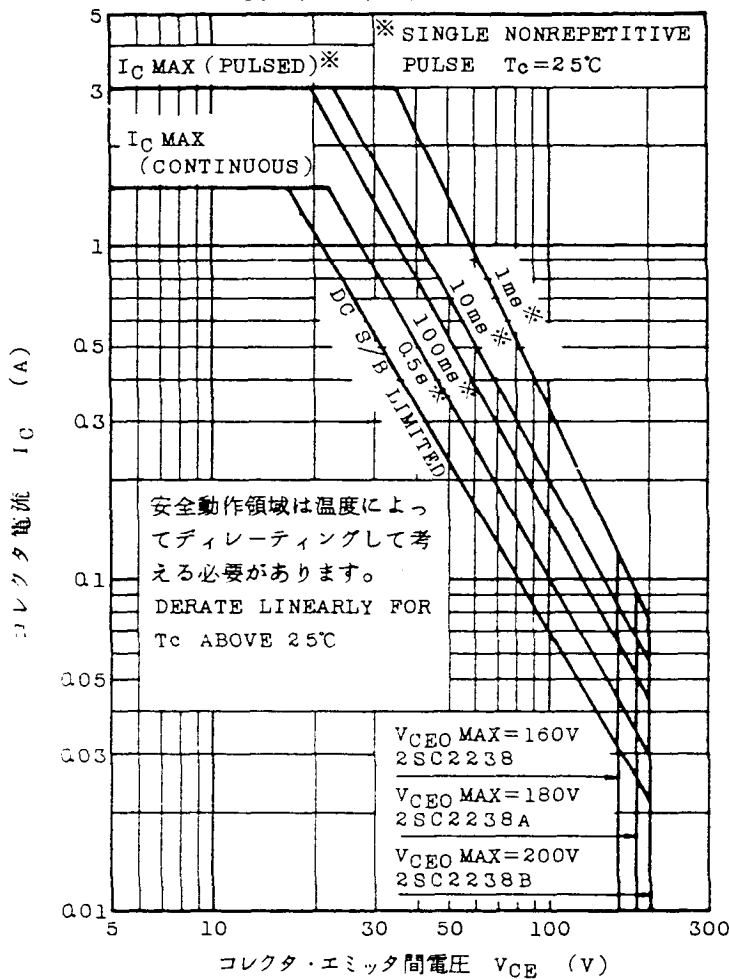


$f_T - I_C$

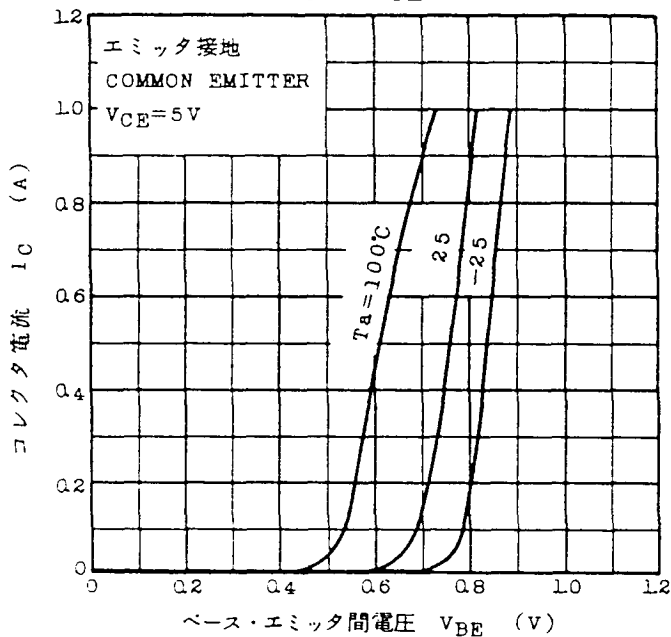


2SC2238・2SC2238A 2SC2238B

安全動作領域 ASO



IC - VBE



PC - Ta

